

Procedeu de creștere a structurii pInP-nCdS, care include amplasarea unui substrat de pInP, corodat preventiv, cu orientarea cristalografică (100) și deorientarea de $3...5^\circ$ în direcția (110) într-un reactor, încălzirea zonei de creștere a substratului și stabilizarea temperaturii în diapazonul de $400...450^\circ\text{C}$, pulverizarea, în flux deschis de oxigen, a soluțiilor de CdCl₂ și SnCl₄ cu formarea pe substrat a unui strat de Cd₂SnO₄, apoi pulverizarea soluțiilor de CdCl₂ și CS(NH₂)₂ cu formarea pe acesta a unui strat de nCdS.